

特点：

- 频率：26~40GHz
- 插入损耗：2.2dB@40GHz
- 均衡量：4.5dB
- 工作温度：-55~+85℃
- 芯片尺寸：0.85×1.3×0.1mm

性能参数：(T_A=+25℃)

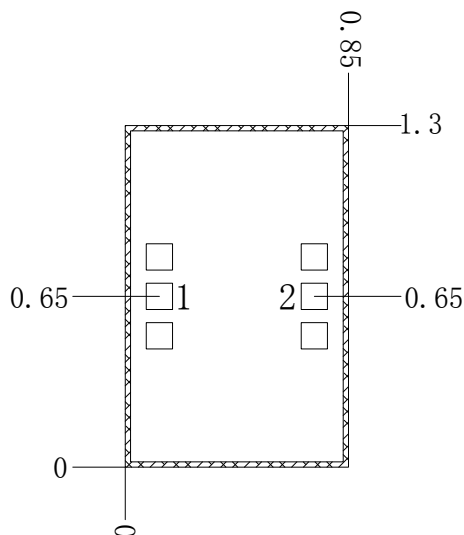
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围	f	Z _{in} =Z _{out} =50Ω	26		40	GHz	
插入损耗	IL			2.2		dB	@40GHz
均衡量				4.5		dB	
输入驻波	VSWR _i			1.4	2		
输出驻波	VSWR _o			1.4	2		

极限参数表：

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
最大输入功率	+30	dBm	贮存温度	-55~+150	℃

芯片尺寸图：

单位：mm

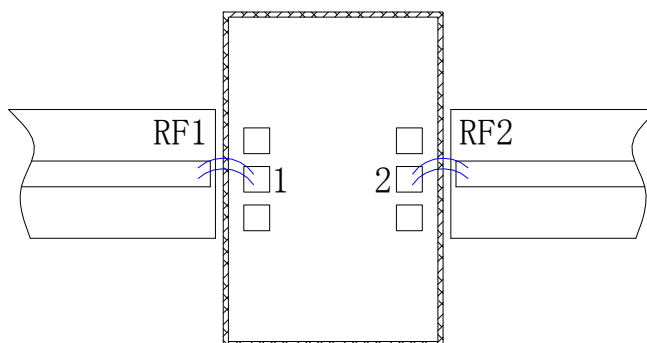


注：典型键合焊盘尺寸为 100*100um

引脚定义：

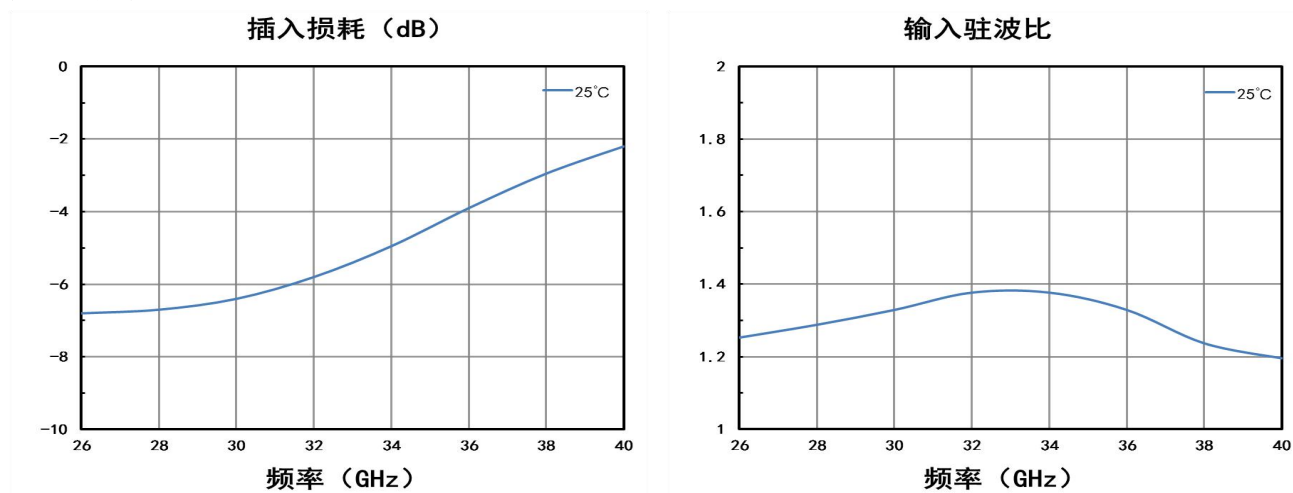
引脚	定义	描述
1	RF1	射频支路端口 1, 50Ω
2	RF2	射频支路端口 2, 50Ω
芯片背面	GND	芯片背面必须接至 RF/DC 地

推荐装配图：

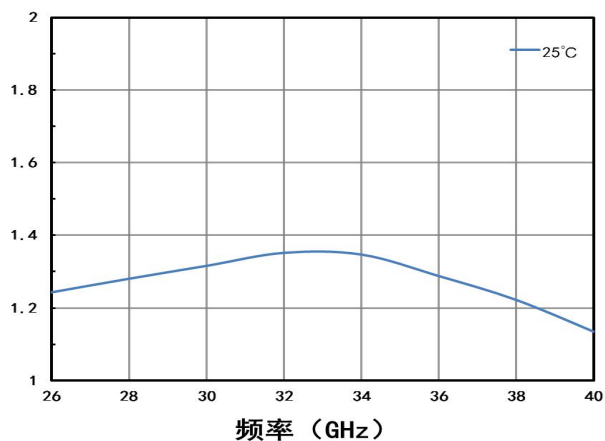


注：未标注的键合焊盘不需要连接

典型测试曲线：



输出驻波比



产品使用注意事项:

- 1.本芯片产品需要在干燥、氮气环境中存储，在超净环境装配使用；
- 2.裸芯片使用的 GaAs 材料较脆，芯片表面容易受损，不能用干或湿化学方法清洁芯片表面使用时必须小心；
- 3.芯片底部用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 295℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
- 4.芯片微波端口与微带线间歇不超过 3 mil，使用 1 mil 双金丝键合，其他端口使用 1 mil 单金丝，建议金丝长度 10~16 mil；
- 5.产品对静电敏感，在存储和使用过程中注意防静电；
6. 其他使用说明详见《裸芯片产品使用说明》。